Simulation and Study of Source temperature effect in gold Thin films growth prepared via evaporation method using COMSOL Multiphysics software

M.H. Ehsani¹; M. Jalali Mehrabad²; A. Javadian³

Received: 2015.11.24 Accepted: 2016.8.25

Abstract

In the present work, gold thin films growth process has been simulated by using the evaporation method. For this purpose, the COMSOL Multiphysics 5.0 simulator software was used. Three-dimensional models were constructed and geometry, mesh analysis, boundary conditions and related relations were defined and studied. Film thickness, density, heat flux and other related parameter to deposition were investigated. Using planar regression, surface equation of the gold thin films was calculated and the effect of the temperature of gold source on thickness of films was investigated. Results showed that there is a correlation between the source temperature and the thickness of gold films. Using non-linear regression, a model was representted in order to describe the dependency of film thickness on source temperature of gold thin films with expected behavior distribution of substrate, a promising accommodation between the simulated data and this trend was observed.

Keywords: Evaporation, Thin film, Simulation.

¹Assistant Professor, Department of Physics, Semnan University

² B.Sc, Department of Physics, Semnan University

³ Lecturer in Physics, Semnan University

محمد حسین احسانی^ا محمود جلالی مهرآباد^ا عباس جوادیان^۳

تاریخ دریافت: ۹۴/۹/۳ تاریخ تصویب: ۹۵/۶/۳

> چکیده در این مقاله، فرآیند لایه نشانی فیلمهای نازک طلا با روش تبخیر حرارتی شبیه سازی شد. بدین منظور از نرم افزار SOL Multiphysics استفاده گردید. مدل سه ^نبعدی در محیط نرم افزار ایجاد و هندسهٔ مدل، تحلیل مشها، شرایط مرزی و روابط مورد نیاز معرّفی گردید. مطالعهٔ ضخامت، چگالی، شار گرما، فشار و سایر پارامترهای مرتبط با لایه نشانی

> > ^۱استادیار فیزیک، دانشگاه سمنان؛ ehsani@semnan.ac.ir ^۲کارشناس فیزیک، دانشگاه سمنان ^۳مربی فیزیک، دانشگاه سمنان

صورت گرفت. با استفاده از برازش صفحه ای، معادلهٔ سطوح نانو فیلم های طلا محاسبه و اثر دمای چشمه بر رشد فیلم های نازک طلا بررسی گردید. نتایج نشان دادند که بین ضخامت فیلم نازک و دمای چشمه رابطهٔ مستقیم وجود دارد. با استفاده از برازش غیر خطی مدلی برای وابستگی ضخامت فیلم نازک به دمای چشمه ارائه گردید. با مقایسهٔ نتایج به دست آمده از شبیه سازی ها در این مورد ضخامت و انحنای سطح فیلم های نازک طلا تطابق مناسبی با رفتار مورد انتظار از توزیع جرم روی زیرلایه مشاهده گردید.

واژه های کلیدی: تبخیر حرارتی، فیلم نازک، شبیه سازی.

 مقدمه
 مقدمه
 یکی از روش های مرسوم برای ساخت لایهٔ ناز ک، روش تبخیر حرارتی در خلأ با استفاده از چشمهٔ گرمایی مقاومتی میباشد که جزء روش های لایه نشانی فیزیکی بخار (PVD) به شمار میرود. در این روش، فرآیند لایه نشانی شامل ۳ مرحلهٔ اصلی است: (الف) تبخیر مادّهٔ مورد نظر برای لایه نشانی به کمک چشمهٔ تبخیر.
 (ب) انتقال بخار مادّه از منبع به زیرلایه.
 (ج) چگالش مادّه روی زیرلایه.
 بلا صورت می گیرد. محیط خلا نیز به کمک پمپهای خلا ایجاد میشود تا هدایت و الا صورت می گیرد. محیط خلا نیز به کمک پمپهای خلا ایجاد میشود تا هدایت و ایتقال مادّهٔ تبخیر شده به سمت زیر لایه تسهیل شود. چگالش مادّه روی زیرلایه نیز از طریق بهم پیوستن اتمهای روی زیرلایه و از طریق فرآیند به می پیوستن جزایر رشد صورت

مي گيرد.

در این روش به کمک ِ برخی کمیّتها، نظیر فشارِ محفظه، تغییرِ هندسهٔ چشمه و زیرلایه، دمای زیرلایه و دمای چشمه و... می توان خواصِّ زیرلایه را کنترل کرد. دمای چشمهٔ تبخیر به جریانِ وارد شده به چشمهٔ تبخیر که در واقع یک مادّهٔ دیر گداز از جنسِ

تنگستن، مولیبدن، تانتالیوم و... است، بستگی دارد. این روش پیشتر در اوایلِ قرنِ بیستم به منظورِ ساختِ آینه های فلزّی از آلومینیوم یا نقره یا قطعاتِ ماشین آلات موردِ استفاده قرار می گرفت [۱].

امروزه به دلیل کاربردهای متعددی که فیلمهای نازک در صنایع و فعالیتهای پژوهشی دارند، آزمایشها و مقالات تجربی بسیاری در این زمینه وجود دارند. در این بین فیلمهای نازک ِطلا نیز به دلیل ِداشتنِ ویژگیهای ساختاری و الکترومغناطیسی خاص، مورد ِتوجّه هستند [۲-۶].

روش های تجربی مطالعهٔ فیلم های ناز ک به خصوص با عناصر گرانبهایی مانند طلا به دلیلِ هزینه بَر بودن و طولانی بودن فرآیندها همواره قابلِ اجرا نیستند. از این رو روش های شبیه سازی لایه نشانی انواعِ مختلف فیلم های نازک اخیراً بسیار مورد توجّه قرار گرفته است. روش های مختلفی برای شبیه سازی لایه نشانی فیلم های نازک وجود دارد که از مهم ترینِ آنها می توان به روش های مونت کارلوی جنبشی (KMC)، جانشانی اتمی تعدیل یافته (MEAM)، بر همکنش های جانشانی اتمی (EAI)، دینامیک ِ مولکولی (MD) و Sport اشاره کرد [۷–۱۱].

در این پژوهش به منظور شبیه سازی لایه نشانی فیلمهای نازک از نرمافزار COMSOL در این پژوهش به منظور شبیه سازی لایه نشانی فیلمهای نازک از نرمافزار Multiphysics 5.0 محاسبات و شبیه سازی های مرتبط با علوم مختلف از قبیل ریاضیات، فیزیک جامدات، ترمودینامیک، الکترومغناطیس، پلاسما و فیزیک ِ شارهها است و دارای کتابخانهٔ جامعی با اطّلاعات مربوط به عناصر ترکیبات مختلف میباشد. ضمناً روابط و معادلات مرتبط با حوزههای مختلف از موجود میباشد.

نویسندگان این مقاله معتقدند که فیزیکدانان تجربی باید در کنار پژوهش های آزمایشگاهی، با نرمافزارهای شبیه سازی رشتهٔ تخصّصی خود آشنا شوند و قبل از انجام آزمایش از آن بهره گیرند. لذا در این کار تلاش شده است تا در راستای ترویج استفاده از این امکانات، ضمن معرفی پتانسیل های این نرمافزار، پدیده های کاربردی را نیز مورد مطالعه قرار دهیم. لذا سعی شده است بر پایهٔ امکانات این مقاله، مراحل مختلف کار از قبیل

طرّاحی هندسهٔ محفظه، چشمه و زیر لایه، تحلیلِ مشها، تعریفِ روابطِ مرتبط با دما، فشار، شار و چگالی شرح داده شوند. شبیهسازی لایه نشانی و مطالعهٔ فیلمهای نازک ِ طلا به روشِ تبخیرِ حرارتی نیز در ادامهٔ کار موردِ مطالعه قرار گرفته است. همچنین با استفاده از نتایج به دست آمده از شبیهسازی، به نحوهٔ توزیع و یکنواختی سطوح در فیلمهای نازک طلا توجّه گردید. وابستگی ضخامتِ فیلمِ نازک به دمای چشمه و معادلاتِ توصیف کنندهٔ آن با استفاده از برازشِ صفحهای و غیرِ خطّی بررسی گردید. با مقایسهٔ نتایجِ شبیهسازی و معادلاتِ نظری موجود، میزانِ خطای شبیهسازی بر آورد گردید.

۲. شبیه سازی و حلّ عددی

1-1. تعريف هندسة محفظة لايه نشاني

طرح وارهٔ سیستم لایه نشانی تبخیر حرارتی در یک محیط سه بعدی در نرمافزار COMSOL در شکل ۱ ارایه شده است. قسمت های مختلف این سیستم در این شکل معرفی شده اند. ابعاد و ویژگی های قسمت های مختلف محفظه نیز در جدول ۱ ذکر گردیده اند. در این شبیه سازی، انتخاب چنین ابعاد و ویژگی ها برای محفظهٔ لایه نشانی به این علّت بوده که ابعاد سیستم های لایه نشانی تبخیر حرارتی، از جمله نمونهٔ موجود در آزمایشگاه تحقیقاتی که نویسندگان این مقاله بدان دستر سی دارند، معمولاً مشابه ابعادی است که در این شبیه سازی به کار رفته اند. چنین انتخابی امکان مقایسهٔ نتایج مطالعات تجربی احتمالی را با نتایج این تحقیق برای پژوه شگران فراهم می آورد.

مدل سه بُعدی ایجاد شده به همراه راستای محورهای دستگاه مختصّات دکارتی در شکل ۲ نشان داده شده است. پایه ها و اتّصالات نگه دارندهٔ محفظه، پمپ خروجی و زیر لایه جهت سادگی در شکل نیامده است. یک نمونهٔ کروی طلا به شعاع Icm (مشابه نمونهٔ گرانولی) که بر روی یک ظرف تنگستن در قسمت پایین محفظه قرار گرفته، به عنوان چشمه تعریف شده است. یک زیر لایه به شکل یک چهارم دایره به شعاع Ivc در فاصلهٔ عمودی ۳۱cm چشمه به صورت متقارن قرار داده شده است. دمای چشمهٔ لایه نشانی قابل تنظیم و بین ۱۵۰۰ تا ۲۱۴۰K (دمای بالاتر از دمای نقطهٔ ذوب طلا) تعریف شده است.



مجلهٔ فیزیک کاربردی دانشگاه الزهرا^(س)، سال ششم، شمارهٔ ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۵ / ۱۱

شکل 1. قسمت های مختلف ِ مدل شبیه سازی شدهٔ محفظهٔ لایه نشانی

دمای محیط	فشار بخار طلا در ۲۰۴۰K	جرمِ مولى طلا	چگالی طلا	نقطهة ذوب طلا	شعاع چشمه	فاصلهٔ چشمه تا زیر لایه	شعاع زير لايه	ار تفاع محفظه
897/10K	۵·Pa	۱۹۷g/mol	۱۹/۳g/cm ³	1889K	١cm	۳۱cm	۱۰cm	۵۰cm

جدول ۱. ابعاد و ویژگیهای چشمه، زیر لایه و محفظه



در مدل سهبعدی، این امکان وجود دارد که بـه جـز محـدودهٔ چشـمه و ظـرفِ تنگسـتن حاوی نمونهٔ طلا، سایرِ سطوحِ موجود در محفظه به عنوانِ محلِّ لایه نشانی نیز انتخاب گردیده تا علاوه بر زیر لایه، لایههای تشکیل شده بر سایرِ نواحی محفظه نیز محاسبه گردند.

به منظور پرهیز از خطاهایی از قبیل اثر لبه ها، اتّصالات بین منبعها، تماس بین سطوح همجوار و...، مِش های مورد نیاز در تمامی سطوح ایجاد شده در مدل محاسبه و ایجاد شدهاند (شکل ۳). مش های ایجاد شده به نسبت ابعاد دیواره ها و سطوح داخلی محفظه به گونه ای انتخاب شدهاند که خطای شبیه سازی به حداقل ممکن برسد. در تحلیل شبکه ایجاد شده، از ترکیب یک استوانه و یک نیم کره استفاده شده است، به این صورت که استوانه و نیم کره داخل مدل سه بعدی محفظه قرار گرفته اند، که در شکل ۳ مشاهده می شوند (دیوارهٔ محفظه به منظور جلوگیری از ابهام پنهان شده است). ابعاد طولی المان های تشکیل دهندهٔ مش ها به نسبت اعث محفظه انتخاب شده است. ایماد و می عوض حدّاقل رساندن اثر لبه ها و اتّصالات بر روی نتایج شبیه سازی می شود، امّا در افزایش می دهد [۳۲–۲۲].



شکل ۳. نمایش مشهای ایجاد شده

به منظور بررسی نحوهٔ توزیع جرم و سایرِ پارامتر های ترمودینامیکی مرتبط با لایه نشانی در محفظه، خصوصاً روی زیرلایه، از یک محیطِ تحلیلگرِ Free Molecular Flow در

(n) نرمافزار استفاده گردید. روابط نظری مربوط به شار بخار مولکولی (G)، فشار (p)، چگالی (n)
و شار گرما (Q) در زمان لایه نشانی به روش تبخیر حرارتی به صورت زیر میباشند [1]:
$$G = -\int_{S'} \frac{J'(n \cdot r)(n'.r)}{\pi r^4} dS'$$

$$p = -\int_{S'} \frac{J'(n \cdot r)^2(n' \cdot r)}{\pi r^5} \frac{Mn}{N_A} \langle C'_{3D} \rangle dS' + \frac{2JMn}{3N_A}, \langle C'_{3D} \rangle = \sqrt{\frac{9\pi RT'}{8Mn}}$$

$$(\Upsilon)$$

که در آن p فشار، J جریانِ بخار، Mn جرمِ مولی، N_A عددِ اتمی و T دما میباشد.

$$n = -\int_{S'} \frac{J'(n \cdot r)}{\pi r^5} \left\langle \frac{1}{C_{3D}'} \right\rangle dS'$$

$$+ 2 \left\langle \frac{1}{C_{3D}} \right\rangle J, \left\langle \frac{1}{C_{3D}'} \right\rangle = \sqrt{\frac{\pi M n}{8RT'}}$$
($\mathbf{\tilde{r}}$)

که در آن n چگالی، J جریانِ بخار Mn جرمِ مولی و T دما است.

$$Q = -\int_{S'} \frac{J'(n \cdot r)(n' \cdot r)}{\pi r^4} \frac{Mn}{N_A} \left\langle C_{3D}^{\prime 2} \right\rangle dS' - \frac{1}{2} \frac{Mn}{N_A} \left\langle C_{3D}^{\, 2} \right\rangle J, \left\langle C_{3D}^{\prime 2} \right\rangle = \sqrt{\frac{4RT'}{Mn}}$$
(F)

که در آن Q شار گرما، L جریان بخار، Mn جرم مولی، NA عدد اتمی و T دما می باشد. زمان لایه نشانی در این شبیه سازی به مدّت ۶۰۶ و طول گامهای طیشده در شبیه سازی و محاسبه پارامتر ها ۶۶ ثانیه تعریف شده است. هدف نویسندگان در پژوهش، مطالعهٔ لایههای طلا با ضخامت های بسیار پایین بوده است، و این بازهٔ زمانی بدان علّت انتخاب شده است. همچنین شایان ذکر است که طول زمانی گامهای طیشده در شبیه سازی بر روی دو پارامتر دقّت نتایج و زمان شبیه سازی می تواند اثر بگذارد. از این رو طول گامها باید به گونه ای انتخاب شود که در عین حداقل بودن خطا، که با کوچک انتخاب کردن طول گامها نتیجهٔ مطلوب تری به دست می آید، از طولانی شدن بیش از حد زمان

شبیه سازی با گامهای زمانی مختلف، طول گامها ۶۶ انتخاب گردید. پارامترهای فشار، چگالی، شار گرما و ضخامتِ فیلمِ نازک ِ تشکیل شده به منظورِ مطالعه تعریف شده و محاسبه گردیدهاند. پس از بررسی تمامی پارامترها و تعاریف، مدلِ طرّاحی و راهاندازی شد و برای ۶۲۱۳۹ درجهٔ آزادی محاسبات صورت گرفت.

- ۳. نتاییج شبیه سازی شکل ۶ تصویر سه بعدی شار فرودی اتم های طلابر روی سطوح محفظه در حین لایه نشانی را نمایش می دهد. ضخامت نمونهٔ لایه نشانی را می توان از طریق شار فرودی تعیین نمود. این وابستگی با رابطهٔ زیر داده شده است [۱]:
- $\frac{dh_{film}}{dt} = \frac{M_n G}{N_A \rho_{film}}$ (۵) $\sum_{k=1}^{N_h} \sum_{k=1}^{N_h} \frac{M_n G}{N_A \rho_{film}}$ $\sum_{k=1}^{N_h} \sum_{k=1}^{N_h} \sum_{k=1}^{N_h} \frac{M_n G}{N_A \rho_{film}}$ $\sum_{k=1}^{N_h} \sum_{k=1}^{N_h} \frac{M_n G}{N_A \rho_{film}}$

در این شبیه سازی گرچه محاسبهٔ شار مولکول ها برای تعیین نرخ لایه نشانی کفایت می کند، امّا به منظور بررسی تأثیر پدیده های رایج دیگر همچون باز تبخیر طلا از سطوح داغ نزدیک به چشمه، از یک برنامهٔ وابسته به زمان استفاده شده است. البتّه انتخاب این برنامهٔ وابسته به زمان منجر به طولانی شدن زمان شبیه سازی گردیده است.



رابطهٔ بین شار، دما و فشارِ بخارِ نمونهٔ موجود در چشمه به صورتِ زیر است [۱].

$$J = \alpha_v \left(\frac{N_A^2}{2\pi M_N RT}\right)^{1/2} p_{vap}$$
(۶)

که در آن Mn جرم مولی، N_Aعدد اتمی، T دما، R ثابت جهانی گازها، *p_{vap} فشار بخار و α*, ثابت لایه نشانی میباشد. ضخامت طلای لایه نشانی شده بر روی سطوح داخلی محفظه پس از اتمام شبیه سازی در شکل ۵ نشان داده شده است. همان گونه که مشاهده می شود در سطوح پایین محفظه به دلیل نزدیکی به چشمهٔ با دمای بالا (۲۰۴۰K) پدیدهٔ باز تبخیر رخ می دهد و لایه های تشکیل شده در این ناحیه از ضخامت ناچیزی نسبت به سطوح بالایی محفظه برخوردار میباشند. بازهٔ تغییرات ضخامت در کلِّ سطوح داخلی بسته به دمای چشمه که در این حالت ۲۰۴۰K بوده است، بین صفر تا ۳۹nm متغیّر است. نحوهٔ این تغییرات در نقاط مختلف نیز در شکل ۵ مشاهده می شود.

فیلم تشکیل شده بر روی زیر لایه در شکل ۶ نشان داده شده است. زیر لایه که به صورت متقارن نسبت به چشمه طرّاحی شده، دارای یک توزیع ضخامت شعاعی می باشد، به گونه ای که با افزایش فاصله نسبت به مرکز آن، ضخامت فیلم از مقدار بیشینه (۳۹nm) به کمترین مقدار خود در لبه های زیر لایه (۳۴/۵nm) کاهش یافته است. این نحوهٔ توزیع متقارن و شعاعی در واقع نتیجهٔ نوع طرّاحی و قرار گیری زیر لایه نسبت به چشمه بوده است که با توجّه به محاسبات و مطالعات نظری صورت گرفته در این زمینه موضوعی قابل انتظار می باشد [۲۱–۱۸]. توزیع پارامترهای چگالی، فشار و شار گرما نیز که مشابه ضخامت دارای توزیع شعاعی می باشند، در شکل های ۷ تا ۹ نشان داده شده اند. شکل ۱۰ توزیع ضخامت فیلم طلا بر روی زیر لایه را در یک نمودار سه بعدی نمایش می دهد.

در ادامه به منظور بررسی اثر دمای چشمه بر روی ضخامتِ فیلمِ نازک ِ تشکیل شـده بـر روی زیر لایه، شبیهسازی برای دماهای مختلف ِ چشمه از ۱۵۰۰K تـا ۲۱۴۰K مجـدداً انجـام گردید. به جز دمای چشمه و فشارِ بخارِ تعادلی طلا، که پارامتری وابسته به دما است، سایر پارامترها در حینِ شبیهسازیها ثابت ماندهاند [۲۲].

دادههای مربوط به ضخامتِ فیلم بر روی زیر لایه به ازای هر دما محاسبه و در نمودارِ سهبُعدی شکلِ ۱۱ نمایش داده شدهاند.



شکلِ 0- ضخامتِ فیلم تشکیل شده بر روی سطوحِ محفظه پس از ۶۰۶









Time=60 s Surface: Outward heat flux (W/m²) A 2.12 0.36 0.34 2.1 0.32 0.3 0.28 2.05 0.26 0.24 0.22 2 0.2 0.18 0.16 1 95 0.14 0 12 0.1 1.9 0.08 0.06 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.05 0.1 0.5 ▼ 1.86 **شکل ۹**- شار گرمای خروجی از چشمه بر روی زیرلایه

همان طور که در شکلِ ۱۰ مشاهده می شود، توزیع جرمِ لایه بر روی زیرلایه غیرِ یکنواخت بوده و در نقطه ای از زیرلایه ماکزیمم مقدار داشته و هرچه به گوشه های نمونه حرکت می کنیم از ضخامتِ لایه ها کاسته می شود (اختلافِ ضخامت بین وسطِ نمونه و انتهای نمونه حدودِ ۳ نانومتر است). این موضوع به عنوانِ رفتاری عادی در نمونه های لایه نشانی شده در سیستمِ تبخیر بوده که در مراجع و مقالاتِ مربوط به آن اشاره شده است [10-19]. این رفتار توسطِ نویسندگان با معادلاتِ نظری متنوعی که توصیف کنندهٔ

توزیعِ ضخامت روی زیرلایه است، ارائه گردیده است. تنوّعِ معادلات بـه دلیلِ تغییراتِ ایجاد شده در هندسهٔ چشمه و زیرلایه میباشد.



شکل ۱۰- نمودار سه بُعدی توزیع ضخامتِ فیلم بر روی زیر لایه

کارهای قابلِ توجّهی هم در موردِ ساختِ لایههای نازک با یکنواختی مناسب گزارش شده که می توان به کنترل زیرلایه در زمان لایه نشانی، لرزاندن زیرلایه در زمان لایه نشانی، اعمال میدان مغناطیسی یا الکتریکی و... اشاره کرد[۲۶-۲۳]. بنابراین با بررسی های انجام شده روی معادلاتِ نظری توزیع جرم ارائه شده توسّطِ دیگران[۳۱-۲۷] و تشابه رفتارِ نتیجهٔ شبیه سازی در این کار به نظر می رسد که معادلهٔ حاکم بر این لایه نشانی را می توان با یک تابع گاوسی نشان داد. دلیلِ این انتخاب، شعاعی بودنِ توزیعِ ضخامتِ فیلم بر روی زیر لایه بوده است، که به خوبی در شکلِ ۱۰-۶ دیده می شود.

تابع گاوس در دو بُعد به صورت زیر نوشته می شود[۳۲]:

$$z = z_0 + A \exp[-\frac{1}{2} \left(\frac{x - x_c}{w_1}\right)^2 - \frac{1}{2} \left(\frac{y - y_c}{w_2}\right)^2] \qquad (\vee)$$
که در آن (۵, ۵, ۵, ۵, ۷, ۷, ۳ و ۲۷ ثابت بوده و باید از طریق برازش محاسبه شوند.



ضخامت لایهٔ تشکیل شده بر روی زیرلایه در دماه ای ۱۵۰۰K تا ۲۱۴۰K محاسبه گردیده است. در این بازهٔ دمایی، رابطهٔ بین دما و فشارِ بخارِ تعادلی طلا در شکلِ ۱۱ نشان داده شده است [۳۳].

در شبیه سازی های انجام شده، به ازای هر دما، فشارِ بخار با استفاده از نمودارِ شکلِ ۱۱ محاسبه و به منظورِ محاسبهٔ ضخامتِ فیلمِ تشکیل شده در آن دما در شبیه سازی استفاده شده است. نتایجِ شبیه سازی ضخامتِ فیلمِ تشکیل شده بر روی زیرلایه در دماه ای مختلف در شکلِ ۱۲ نشان داده شده است.



شکل ۱۲ – توزیع ضخامتِ فیلم بر روی زیرلایه به ازای دماهای ۱۵۰۰K تا ۲۱۴۰K

بینِ داده های مربوط به ضخامتِ فیلم در دماه ای مختلفِ چشمه و رابطهٔ (۵) برازشِ صفحه ای صورت گرفته است. نتایج برازش برای دماه ای مختلف به همراه ضرایب همبستگی و نتایج آزمونِ کای دو (chi-square، که یک کمیّت آماری است و نشان دهندهٔ میزانِ خطای برازش بوده و هرچه مقدارِ آن به صفر نزدیکتر باشد، خطای رخ داده در برازش کمتر می باشد) در جدولِ ۲ نشان داده شده است.

Temperature (K)	R ²	Chi-Square	Z ₀	А	x _c	W_1	y _c	W_2
10	•/٩٩٨٩٨	4/229×1.	۰/۰۰۹	./.10	• / ۲۵۰	• /٣٣۴	./10.	• /٣٣٣
140.	•/٩٩٨٩٨	1/221×19	•/0.9	• /VA •	• / ۲۵ •	•/٣٣۴	•/٢٥٠	• /٣٣٣
14	•/٩٩٨٩٨	4/000 × 19	•/979	1/041	• / ۲۵۰	• / ٣٣۴	•/٢۵٠	• /٣٣٣
140.	•/٩٩٨٩٨	1/DAA×10	1/179	4/114	• / ۲۵۰	•/٣٣۴	•/٢٥٠	• /٣٣٣
19	•/٩٩٨٩٨	$\Delta/\Upsilon \cdot 1 \times 1 \cdot^{-\Delta}$	۳/۳۰۶	0/119	• / ۲۵۰	•/٣٣۴	•/٢٥٠	• /٣٣٣
190.	·/٩٩٨٩٨	1/9.7×1. ⁻⁴	۵/۸۰۱	9/101	• / ۲۵۰	• /٣٣۴	./10.	• /٣٣٣
۲	•/٩٩٨٩٨	4/997×1+	٩/٨٩٧	10/970	• / ۲۵۰	• / ٣٣۴	./10.	• /٣٣٣
714.	•/٩٩٨٩٨	۷/۲۳۱×۱۰ ^{-۳}	۳۸/۹۷۶	91/084	۰/۲۵۰	• /٣٣۴	•/٢٥٠	· /٣٣٣

جدول ۲- نتایج برازش داده های مربوط به ضخامت فیلم با رابطهٔ (۷)

داده های شبیه سازی شده مربوط به ضخامت به همراه سطوح گاوسی محاسبه شده از طریق برازش صفحه ای در شکل ۱۳ نشان داده شده اند. همان طور که از این شکل و جدول ۲ مشاهده می شود، ضخامت فیلم ناز ک طلا به دلایلی که در بالا اشاره شد، با افزایش دمای چشمه زیاد می شود. دلیل این افزایش می تواند این موضوع باشد که متناسب با افزایش دمای چشمه، فشار بخار تعادلی طلا به مقدار چشمگیری افزایش می یابد؛ چنانچه به خوبی در شکل ۱۱ قابل مشاهده است. این افزایش فشار بخار باعث می شود تا شار بخار مولکولی طلای تبخیر شده از چشمه به سمت زیرلایه مطابق با رابطهٔ (۶) افزایش یابد [۱]. این افزایش شار مولکولی افزایش ضخامت فیلم تشکیل شده بر روی زیرلایه را در پی دارد. برای مشاهده بهتر این موضوع نمودار ضخامت فیلم در یکی از نقاط واقع در مرکز زیر لایه بر حسب زمان برای دماهای مختلف محاسبه شده است (شکل ۱۴



با استفاده از برازشِ غیرِ خطّی، دادههای مربوط به بیشینهٔ ضخامتِ ایجـاد شـده بـر روی زیر لایه در دماهای مختلف با رابطهٔ زیر برازش داده شد:

$$t = Y_0 + A \exp(-\frac{T}{B}) \tag{A}$$

که در آن ₄V₀ A و B ثابت بوده باید از طریق برازش محاسبه گردند. نتایج برازش صورت گرفته به همراه ضریب همبستگی برازش غیر خطی (R²) در جدول ۳ آمده است. همچنین شکل ۱۵ داده های شبیه سازی شده همراه با خط برازش را نشان می دهد. از رابطهٔ (۸) می توان برای پیش بینی ضخامت فیلم های نازک طلا در دماه ای مختلف چشمه استفاده نمود. البته لازم به ذکر است که چون دمای چشمهٔ تبخیر به شدت بر روی فشار بخار تعادلی تأثیر می گذارد، با توجه به شکل ۱۱ و نیز رابطهٔ (۶)، اثر دمای چشمه بر روی فشار بخار و در نتیجه بر روی شار مولکولی بخار ماده را نیز باید در نظر گرفت. این موضوع دقت نتایج را به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.

مدل برازش	R	\mathbf{Y}_0	A	В
$t = Y_0 + A \exp(-\frac{T}{B})$	•/٩٩٩	-•/٨۵۴	۸/440×۱۰-۲	-1.7/201

جدول ۳- نتایج برازش داده های شبیه سازی شده مربوط به ضخامتِ فیلم با رابطهٔ (۸)



شکلِ 10- نتایج برازشِ غیرِ خطّی داده های مربوط به بیشینهٔ ضخامتِ فیلم بر حسبِ دما

٤. نتیجه گیری
لایه نشانی فیلمهای نازک طلابه روش تبخیر حرارتی با استفاده از نرمافزار لایه نشانی فیلمهای نازک طلابه روش تبخیر حرارتی با استفاده از نرمافزار مجاور مجافز محمله ای محافز محفظه لایه نشانی بررسی گردید. مشاهده شد که بین دمای چشمه با چشمهٔ داغ درون محفظه لایه نشانی بررسی گردید. مشاهده شد که بین دمای چشمه با مخامت فیلم نازک تشکیل شده بر روی زیر لایه رابطهٔ مستقیم وجود دارد. رابطهٔ (۸) به مخامت فیلم نازک تشکیل شده بر روی زیر لایه رابطهٔ مستقیم وجود دارد. رابطهٔ (۸) به محاسب فیلم نازک تشکیل شده بر روی زیر لایه رابطهٔ مستقیم وجود دارد. رابطهٔ (۸) به محاسب گردید. همچنین معادلهٔ سطح فیلم نازک تشکیل شده بر روی زیر لایه رابطهٔ مستقیم وجود دارد. رابطهٔ (۸) به محاسب گردید. همچنین معادلهٔ سطح فیلم نازک تشکیل شده بر روی زیر لایه در دماهای محاسب کردید. محمه از طریق برازش غیر خطی محاسب کردید. تغییرات ضخامت فیلم نازک بر محاسب دما در این شبیه سازی به خوبی با رابطهٔ (۶) که در بردارندهٔ توصیف فیزیکی توزیع محسب دما در این شبیه سازی به خوبی با رابطهٔ (۶) که در بردارندهٔ توصیف فیزیکی توزیع محاسب کردید. تغییرات ضخامت فیلم نازک بر مخامی مخامت فیلم نازک بر محاسب گردید. می با استفاده از برازش منازی محاسبه گردید. تغییرات ضخامت فیلم نازک بر مخامی فیلم نازک بر مخامی فیزیکی توزیع مخامی فیلم است، مطابقت دارد. از مدل ارائه شده می توان برای توصیف و پیش بینی ضخامت فیلمهای نازک طلا در دماهای مختلف چشمه بهره برد.

٥. مراجع

[1] M. Ohering, Materials Science of Thin Films, Deposition and Structure", (2002), 2nd Edition, New York, Academic Press.

[2] K.E. Harris, V.V. Singh, A.H, King, "Grain rotation in thin films of gold". Acta Mater, **46** (1998) 2623-2633.

[3] H.D. Espinosa, B.C. Prorok, "Size effects on the mechanical behavior of gold thin films". Journal of Materials Science, **38**. (2003) 4125 – 4128.

[4] L. Hultman, A. Robertsson, H. T. G. Hentzell, I. Engström and P. A. Psaras. "Crystallization of amorphous silicon during thin-film gold reaction". Journal of Applied Physics,**62** (1987) 3647.

[5] L. John "Janning Thin film surface orientation for liquid crystals". Applied Physics Letters, **21**(1972) 173.

[6] D. Krause, C.W. Teplin, C.T. Rogers, "Optical surface second harmonic measurements of isotropic thin-film metals: Gold, silver, copper, aluminum, and tantalum". Journal of Applied Physics, **96** (2004) 3626.

[7] C.H. Claassens, J.J. Terblans, M.J.H. Hoffman, H.C. Swart, "Kinetic Monte Carlo simulation of monolayer gold film growth on a graphite substrate" Surf. Interface Anal, **37**(2005) 1021–1026.

[8] C.L. Kuo, P. Clancy, "MEAM molecular dynamics study of a gold thin film on a silicon substrate". Surface Science, **551**(2004) 39–58.

[9] W.D. Luedtke, U. Landman,. "Metal-on-metal thin-film growth: Au/Ni(001) and Ni/Au(001)" Physical Review B, 44.(1991) 5970.

[10] H. Zheng. "Molecular Dynamic Simulation of Thin Film Growth Stress Evolution". Theses and Dissertations, (2011) Paper 1256.

[11] A. Axelevitch, B. Apter, G. Golan, "Simulation and experimental investigation of optical transparency in gold island films". Optics Express **21** (2013)4126.

[12] A. Musset, S. Dvorak, "Basic in Action" (1984). Chap 12, Butterworth.

[13] S. Bosch,. "Computer-aided procedure for optimization of layer thickness uniformity in thermal evaporation physical vapor deposition chambers for lens coating". J. Vac. Sci. Technol. A,**10** (1992) 98.

[14] H.A. Macleod, "Thin-Film Optical Filters". (1986), Macmillan Publishing Company, New York.

[15] I. Fuke, V. Prabhu, S. Baek, "Computational Model for Predicting Coating Thickness in Electron Beam Physical Vapor Deposition". J. Manufacturing Processes, **7** (2005) 140.

[16] J.B. Oliver, D. Talbot, "Optimization of Deposition Uniformity for Large-aperture National Ignition Facility Substrates in a Planetary Rotation System". Appl. Opt. 45, (2006) 3097.

[17] E. N. Kotlikov, V.N. Prokashev, V.A. Ivanov, A.N. Tropin, "Thickness Uniformity of Films Deposited on Rotating Substrates". J. Opt. Technol. **76** (2009) 100.

[18] F. Wang, R. Crocker, R. Faber, "Large-area Uniformity in Evaporation Coating through a New Form of Substrate Motion". Optical Interference Coatings (2010).

[19] D.J. Woodland, E. Mack Jr. "The Effect of Curvature of Surface on Surface Energy. Rate of Evaporation of Liquid Droplets. Thickness of Saturated Vapor Films". J. Am. Chem. Soc., 55 (8), (1993)3149.

[20] R. Schmidt, M. Parlak, A.W. Brinkman, "Control of the thickness distribution of evaporated functional electroceramic NTC thermistor thin films". Journal of Materials Processing Technology, 199, (2008)412.

[21] O. Piot, A. Malaurie, J. Machet, "Experimental and theoretical studies of coating thickness distributions obtained from high rate electron beam evaporation sources". Thin Solid Films, 293(1997) 124.

[22] L.D. Hall "The Vapor Pressure of Gold and the Activities of Gold in Gold-Copper Solid Solutions". J .Am. Chem .Soc, 73, (2)(1951) 757.

[23] F.H. Siyanaki, H.R. Dizaji, M.H. Ehsani, S. Khorramabadi, "The effect of substrate rotation rate on physical properties of cadmium telluride films prepared by a glancing angle deposition method" Thin Solid Films **577**(2015) 128–133.

[24]M. Panjan, "Influence of substrate rotation and target arrangement on the periodicity and uniformity of layered coatings", Surface & Coatings Technology **235** (2013) 32–44.

[25] A. Rauch, R.J. Mendelsberg, J.M. Sanders, A. Anders, J. Appl. Phys. **111** (2012) 083302.

[26] A. Anders, Handbook of Plasma Immersion Ion Implantation and Deposition, Wiley, 2000

[27] L. Holland; W. Steckelmacher; "the distribution of thin films condensed on surfaces by the vacuum evaporation method"; Vacuum **2**, (4) (1952) 346.

[28] C. C. Jaing; M. H. Cheng; J. S. Chen; C. H. Tsai; P. S. Yeh; J. S. Kao; H. Y. Hsiao; "Studying layer uniformity of sputter coatings by intensity distribution of plasma spectrum"; Applied Surface Science **169-170**, (2001) 649-653.

[29] J. Wang; J. Shao; K. Yi; Z. Fan; "Layer uniformity of glancing angle deposition"; Vacuum **78**, (2005) 107–111.

[30] M. Panjan; "Influence of substrate rotation and target arrangement on the periodicity and uniformity of layered coatings"; Surface & Coatings Technology **235**, (2013) 32–44.

[31] S. Todorova; D. Popov; E. Dimitrov; D. Dochev; M. Kanev; "Thickness uniformity of vacuum deposited layers"; Vacuum **38**, (1988) 869-872.

[32] Hagen N. Dereniak E.L. "Gaussian profile estimation in two dimensions," Appl. Opt. **47** (2008) 6842-6851.

[33] G.M. Sant'Anna, D.S. Roveri, H.H. Bertan, J.F. Mologni, E.S Braga, M.A.R Alves, J. of. Electrostatic. 74 (2015) 96-101.